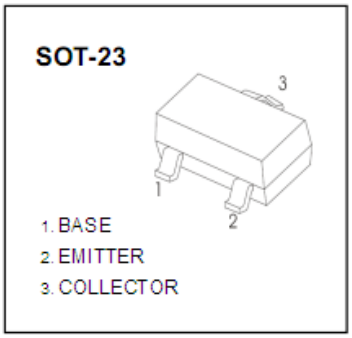
SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

S8050（ NPN ）



印章/Marking：J3Y

用途/Applications：

用于功率放大电路，与 S8550 互补。

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	0.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	℃
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55～150	℃

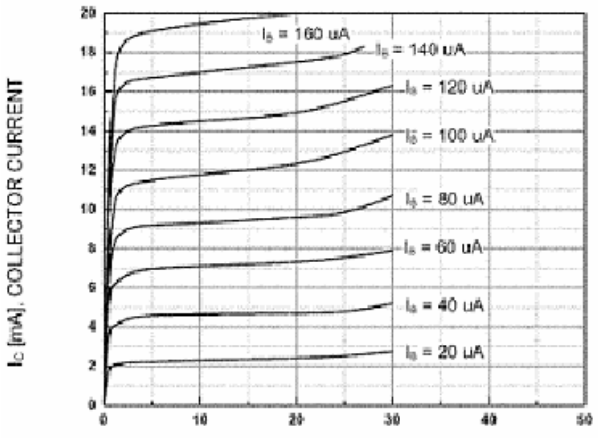
电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	I_C=100μA, I_E=0	40			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	I_C=1mA, I_B=0	25			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	I_E=100μA, I_C=0	5			V
集电极截止电流	I_{CBO}	V_{CB}=40V, I_E=0			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	V_{EB}=5V, I_C=0			0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CEO}	V_{CE}=20V, I_B=0			0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=1V, I_C=50mA	120		350	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=1V, I_C=500mA	50			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	I_C=500mA, I_B=50mA			0.6	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	I_C=500mA, I_B=50mA			1.2	V
特征频率	f_T	V_{CE}=6V, I_C=20mA, f=30MHz	150			MHz

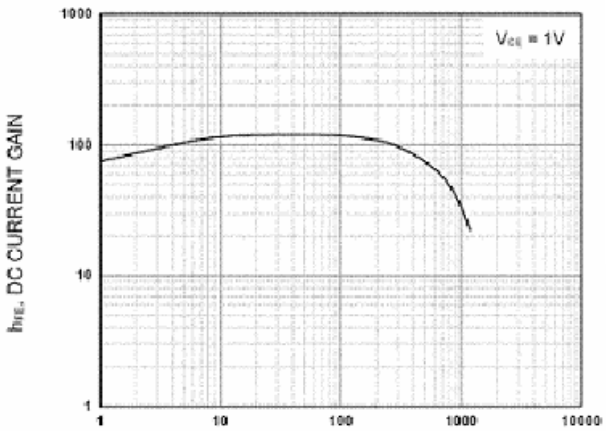
h_{FE}分档/Classification of $h_{FE(1)}$

档位/Rank	L	H
范围/Range	120～200	200～350

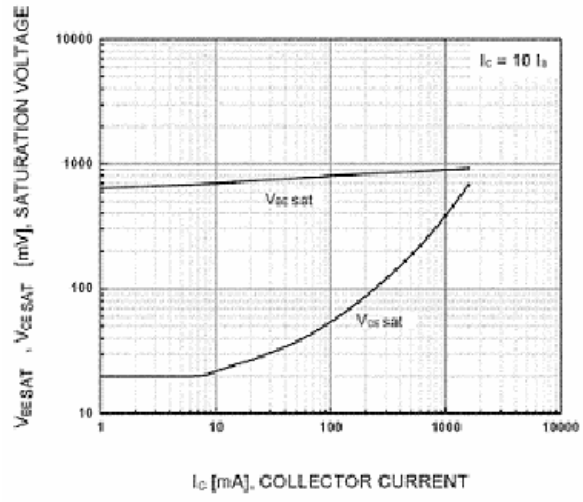
典型特性曲线图/Typical Characteristics



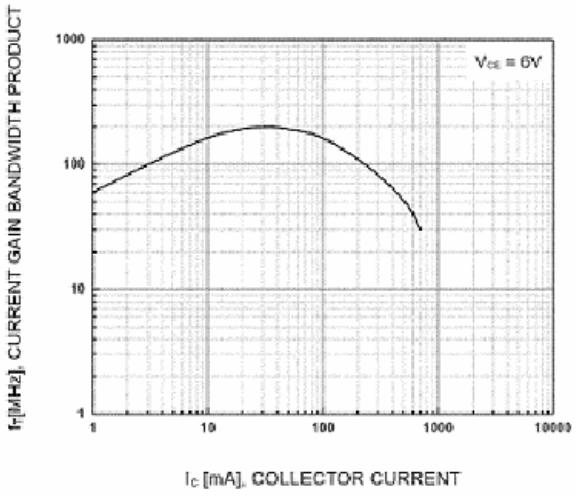
Static Characteristic



DC current Gain



Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage



Current Gain Bandwidth Product